В.Л. Ланин

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАГРЕВ В ПРОЦЕССАХ ПАЙКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ул.П.Бровки, 6, г. Минск, 220013, Республика Беларусь

Воздействие энергии высокочастотных (ВЧ) электромагнитных колебаний позволяет осуществлять высокопроизводительный бесконтактный нагрев при пайке деталей и припоя с помощью наведенных в них вихревых токов, а также активировать припой и улучшить его растекание по паяемым поверхностям. Качество паяных соединений зависит от следующих факторов ВЧ нагрева: времени, скорости, площади зоны нагрева, плотности мощности и др. [1]. Эффективность нагрева определяется электрофизическими свойствами материалов деталей, частотой тока и конструктивными параметрами индукционных устройств. Вследствие поверхностного эффекта тепловая энергия локализуется в тонком слое, толщина которого определяется глубиной проникновения токов ВЧ. Пайка электронных устройств характеризуется невысокой удельной мощностью нагрева, малыми габаритами паяемых деталей, чувствительностью электронных устройств к электромагнитным наводкам. Поэтому для оптимизации параметров ВЧ нагрева в процессах пайки электронных устройств необходимы аналитические зависимости для вычисления эффективной мощности, выделяемой в зоне нагрева и коэффициента полезного действия (КПД) нагрева.

Эффективная мощность ВЧ нагрева в общем случае определяется согласно следующего выражения [2]

$$P_{_{3\phi}} = \frac{U_{_{3\phi}}^2 \cos \varphi \eta}{R_{_{H}}},\tag{1}$$

где $U_{3\phi}$ – эффективное напряжение на индукторе, соз ϕ - коэффициент мощности, η - кпд ВЧ нагрева, $R_{\rm H}$ – электрическое сопротивление токам ВЧ в зоне нагрева.

Для оптимизации пайки соединений различного типа необходимо получить выражения для cosφ и η. Коэффициент мощности ВЧ нагрева зависит от величины зазора h между поверхностью детали и индуктором, а также от глубины проникновения δ токов ВЧ и магнитной проницаемости μ материала

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + (1 + \sqrt{2}\frac{h}{\delta \cdot \mu})^2}}.$$
(2)

Учитывая, что

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\mu_0 \mu \cdot f}},\tag{3}$$

где ρ - удельное электрическое сопротивление материала, f - частота тока, а μ₀ - магнитная постоянная, получим

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + (1 + \sqrt{2\mu_0}h\sqrt{\frac{f}{\rho_o \cdot \mu}})^2}} \,. \tag{4}$$

В процессах пайки соединений телескопического типа используют схему ВЧ нагрева с индуктором кольцевого типа (рис.1). При увеличении зазора h от 1 до 10 мм на частотах от 400 до 2000 кГц коэффициент мощности для диамагнетиков падает почти в 10 раз, а для ферромагнетиков - в 3 – 4 раза (рис. 2). Поэтому для нагрева диамагнитных материалов необходимо уменьшить величину зазора для значений, обеспечивающих нормальную работу индуктора.

КПД ВЧ нагрева определяется соотношением электрических сопротивлений индуктора R_и и материала детали в зоне нагрева R_д [3]

$$\eta = \frac{R_{o}}{R_{o} + R_{u}} = \frac{1}{1 + R_{u} / R_{o}}.$$
(5)

В индукционных устройствах ВЧ нагрева деталей небольших размеров необходимо в формуле (5) учитывать также активное сопротивление токоподвода R_{TU}, соединяющего индуктор с генератором и которое по величине сравнимо с R_и.

При определении R_u допускаем, что ток ВЧ в индукторе протекает в основном в слое глубиной δ_u , а длина индуктора зависит от его диаметра витка D_u и числа витков N

$$R_u = \frac{ND_u \sqrt{\rho_u \mu_0 \cdot f}}{d_u}, \qquad (6)$$

где d_и – диаметр трубки индуктора.

Подставив значения констант р_и, µ0 и приняв размерность частоты в МГц, получим

$$R_u = 0.15 N D_u \frac{\sqrt{f}}{d_u}, \text{ MOM}$$
⁽⁷⁾

При тех же допущениях сопротивление токоподвода

$$R_{TH} = 2\rho_u \frac{L_{TH}}{\pi \cdot d_u \delta_u} \,. \tag{8}$$

С учетом выражения (3), получим

$$R_{TH} = 2L_{TH} \frac{\sqrt{\rho_u \mu_0 f}}{\pi \cdot d_u}.$$
(9)

Подставив значения констант

$$R_{TH} = 0.1L_{TH} \frac{\sqrt{f}}{d_u}, \text{ MOM.}$$
(10)

Тогда КПД нагрева определяется выражением

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R_u + R_{TH}}{R_o}} = \frac{1}{1 + \frac{(0.15ND_u + 0.1L_{TH}) \cdot \sqrt{f}}{R_o \cdot d_u}}.$$
(11)

Электрическое сопротивление токам ВЧ в зоне нагрева можно определить из предположения, что ширина зоны нагрева при малых величинах зазора h определяется проекцией диаметра индуктора, а длина зоны – кольцом длиной $\pi \cdot ND_{\pi}$ (рис. 1)

$$R_{\partial} = \frac{\rho_{\partial} N \pi D_{\partial}}{d_{u} \delta}.$$
 (12)

С учетом выражения (3) получим

$$R_{\partial} = \frac{\pi N D_{\partial}}{d_{H}} \sqrt{\frac{\rho_{\partial}}{\mu_{0} \rho f}} \quad .$$
(13)

Электрическое сопротивление в зоне ВЧ нагрева линейно снижается с уменьшением числа витков индуктора, диаметра детали. Максимальные значения КПД на уровне 0,9-0,.95 достигаются для магнитных материалов при D_д ≤ 0,01 м (рис. 3).

Подставим выражения (4), (11), (13) в (1) и ,сделав преобразования, получим итоговое выражение для эффективной мощности ВЧ нагрева

$$P_{_{3\phi}} = \frac{U_{_{3\phi}}^2}{\left(\sqrt{1 + (1 + \sqrt{2\mu_0}h\sqrt{\frac{f}{\rho_o\mu}})^2}\right)\left(1 + \frac{(0,15ND_u + 0,1L_{_{TH}})f}{\pi ND_o}\sqrt{\frac{\rho\mu\mu_0}{\rho_o}}\right)}.$$
(14)

Эффективное напряжение на индукторе зависит от типа ВЧ генератора и составляет 50 - 500 В, при этом мощность нагрева изменяется от 1 до 100 кВт в зависимости от магнитных и электрических свойств материалов (рис. 4). Магнитные материалы при прочих равных условиях требуют меньшей удельной мощности. Общей закономерностью для всех магнитных материалов является нелинейное снижение мощности нагрева в зависимости от частоты токов ВЧ, что связано с проявлением поверхностного эффекта. Однако снижение частоты тока увеличивает электродинамический эффект перемешивания расплавленного припоя и повышает тем самым его растекаемость.

При пайке корпусных электронных устройств, чувствительных к электрической составляющей поля, выбор частоты необходимо осуществлять из условия [4]

$$\delta < H/4, \tag{15}$$

где Н- толщина стенки корпуса.

В этом случае напряженность поля внутри корпуса будет ослаблена в 100 раз по сравнению с поверхностью, что исключит деградацию электронных компонентов. Нижняя граница частотного диапазона с учетом соотношения (15) определится как

$$f_{min} > 4.10^6 \rho/\mu H^2$$
 (16)

Верхняя граница частотного диапазона выбирается исходя из максимального КПД нагрева.

Исследования проведены для 2-х типов индукционных устройств: кругового (рис.5) и на незамкнутом магнитопроводе (рис. 6). Первое устройство содержало круговой индуктор с цилиндрическим магнитным сердечником, ВЧ генератор, пирометр. Во втором устройстве генератор 1 подключался к обмотке индуктора с магнитопроводом 2 из ферромагнитного материала. В зазоре магнитопровода нагревались детали 4. Обмотка подмагничивания постоянным током подключена к входу регулирующего выпрямителя 3. Температура в рабочей зоне измерялась термопарой и регистрировалась прибором 6. Напряженность ЭМ поля в зазоре воспринималась рамкой и оценивалась прибором 7. Параметры ЭМ поля контролировались на выходе генератора с помощью стандартных приборов. Величина тока подмагничивания варьировалась переменным резистором R.

Зависимости напряженности ЭМ поля от анодного напряжения носят нелинейный характер (рис.7). Для второго типа индуктора напряженность поля в 4,5 раза выше ввиду концентрации магнитного поля.

Термические зависимости для пайки корпусов интегральных схем (рис.8) показали влияние конструкции индуктора кругового типа. 2-х витковый индуктор с витками в одной плоскости (2) имеет более пологий участок кривой нагрева, чем у одновиткового индуктора (3). Это создает более равномерный нагрев деталей, соединяемых пайкой, способствует более полному заполнению припоем зазора между соединяемыми деталями при сравнительно небольшом времени пайки – не свыше 10 с. Применение магнитопровода из феррита (1) повышает эффективность нагрева в 1,6 – 1,7 раза, сокращая тем самым время пайки.

Анализ зависимостей температуры в рабочей зоне устройства на незамкнутом магнитопроводе от времени нагрева и коэффициента перекрытия зазора K_n , показал, что на первом этапе нагрева (до 10 с) скорость нагрева составляла 60 °С/с, в дальнейшем скорость уменьшилась до 20 °С/с, что объясняется увеличением потерь энергии в окружающую среду за счет излучения. При $K_n>1$ рассеяние тепла происходит с большей скоростью. Материалы с низкой электропроводностью при оптимальном перекрытии зазора испытывают нагрев со скоростью до 30⁰ С/с. Напряженность электромагнитного поля в зазоре на низких частотах 20 – 60 кГц составляла (2.0 – 2.5) * 10⁴ А/м.

Для повышения качества паяных соединений за счет увеличения площади растекания припоя и более полного заполнения им капиллярных зазоров в соединении с момента начала растекания припоя до окончания пайки паяемому изделию сообщали низкочастотные вибрации путем подачи переменного тока подмагничивания частотой 50-400 Гц и амплитудой 1-10 А в индуктирующую обмотку. Амплитуда вибраций деталей составляла 0,5 – 1,0 мм.

ВЧ нагрев в диапазоне частот 1200 – 1500 кГц характеризуется большей зависимостью от величины мощности и электрофизических характеристик материалов. При мощности нагрева 1 кВт напряженность поля составляет 4.5*10⁴ А/м, а время пайки магнитных материалов – 5 с (рис.9).

Оптимизация параметров ВЧ нагрева энергии позволила обеспечить высокую скорость нагрева в локальных зонах формирования паяных соединений и улучшить их качество за счет совместного действия поверхностного эффекта и пондеромоторных сил. Предпочтительным является индуктор на магнитопроводе, так как у него более высокий КПД за счет снижения излучения в окружающее пространство.

Литература

 Thwaites C.J. Soldering technology - a decade of developments // Int. Metals. Rev. 1984. V.29. № 2. P.45-74.

- Benkowsky G. Grundlagen der Induktionserwarmung// Elektro-Praktiker. 1974.Bd 28. № 8. S. 265-268.
- 3. Вологдин В.В., Кущ Э.В., Асамов В.В. Индукционная пайка. Л.: Машиностроение, 1989.
- Ланин В.Л., Хмыль А.А. Современные процессы пайки в производстве РЭА. Мн.: БелНИИНТИ, 1988.
- Ланин В.Л., Тявловский М.Д. Особенности высокочастотного нагрева при герметизации пайкой корпусов БИС // Электронная техника. Сер. 7. 1980. № 3(100). С.11-14.
- Ланин В.Л., Черник А.А. Герметизация интегральных схем электромагнитным нагревом // Известия Белорусской инженерной академии. 2000. № 1(9)/2. С. 132-133.
- 7. *Ланин В.Л.* Эффективность нагрева концентрированными потоками энергии при пайке в электронике // Электронная обработка материалов.2002. №2. С.17- 20.
- 8. Ланин В.Л. Моделирование высокочастотного электромагнитного нагрева в процессах пайки электронных устройств // Известия Белорусской инженерной академии. 2002. № 2(14)/2. С. 167-169.

Поступила

2003

УДК 621.365 (075.6)

Высокочастотный электромагнитный нагрев в процессах пайки электронных устройств. Ланин В. Л.// Электронная обработка материалов. 2004. № (). С.

Исследованы и оптимизированы параметры высокочастотного нагрева для индукционных устройств кругового типа и на незамкнутом нагнитопроводе. Определен частотный диапазон для пайки корпусных электронных устройств. Библиогр. 8. Ил. 9.



материалов: 1- ковар, 2- сталь, 3- олово, 4- алюминий



Рис. 3. Зависимости кпд ВЧ нагрева от диаметра детали и свойств материалов: ковар, 2 - сталь, 3 - олово, 4 - алюминий



Рис. 4. Зависимости мощности ВЧ нагрева от напряжения на индукторе и свойств материалов: 1 – олово, 2 – алюминий, 3 - сталь, 4 – ковар



Рис.5. Схема нагрева круговым индуктором: 1– генератор, 2 –пирометр, 3 – индуктор, 4 – магнитный сердечник, 5 – детали, 6 – термоизолятор

1 –



Рис.7. Зависимости напряженности ЭМ поля от анодного напряжения

600



Рис. 8. Термические зависимости в зоне пайки ИМС



Рис. 9. Зависимости времени пайки от мощности ВЧ нагрева